



**Государственное научно-производственное объединение
«Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника»**

**Открытое акционерное общество «ИНТЕГРАЛ» – управляющая
компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»**

ПРОГРАММА

**III международная научно-техническая конференция
«Микро-, Опто- и СВЧ-Электроника – 2025»**

14–17 октября 2025 года, г. Минск, Беларусь

Место проведения

Конференция будет проходить в здании Института физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси по адресу:

г. Минск, проспект Независимости, 68.

Секционные заседания будут проходить в большом конференц-зале Института физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси

Стендовая секция и перерывы на кофе будут проходить в холле большого конференц-зала Института физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси

Расписание конференции

14 октября, вторник		15 октября, среда		16 октября, четверг		17 октября, пятница	
		9 ⁰⁰ -11 ⁰⁰	Регистрация участников и приветственный кофе	9 ⁰⁰ -10 ⁴⁰	Секция №3 (5 докладов)	9 ⁰⁰ -10 ⁴⁰	Секция №6 (5 докладов)
		11 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	Пленарная секция (открытие, 4 доклада)	10 ⁴⁰ -11 ²⁰	Перерыв на кофе	10 ⁴⁰ -11 ²⁰	Перерыв на кофе
		13 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	Перерыв на обед	11 ²⁰ -13 ⁰⁰	Секция №4 (5 докладов)	11 ²⁰ -13 ⁰⁰	Секция №7 (5 докладов)
		14 ⁰⁰ -15 ⁴⁰	Секция №1 (5 докладов)	13 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	Перерыв на обед	13 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	Перерыв на обед
14 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	Регистрация участников	14 ⁰⁰ -15 ⁴⁰	Секция №1 (5 докладов)	14 ⁰⁰ -15 ⁴⁰	Секция №5 (5 докладов)	14 ⁰⁰ -15 ⁴⁰	Секция №8 (5 докладов)
15 ⁴⁰ -16 ²⁰		Перерыв на кофе	15 ⁴⁰ -16 ²⁰	Перерыв на кофе	15 ⁴⁰ -16 ²⁰	Перерыв на кофе	
16 ²⁰ -18 ⁰⁰		Секция №2 (5 докладов)	16 ²⁰ -18 ⁰⁰	Стендовая секция (38 докладов)	16 ²⁰ -18 ⁰⁰	Секция №9 (4 доклада, закрытие)	
		18 ⁰⁰ -21 ⁰⁰	Ознакомительный ужин				

15 октября, среда

09⁰⁰–11⁰⁰ Регистрация участников и приветственный кофе

11⁰⁰–13⁰⁰ Пленарная секция

11⁰⁰–11²⁰ Открытие конференции

М.В. Богданович, генеральный директор ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь

А.С. Буйневич, генеральный директор ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», Минск, Беларусь

11²⁰–11⁴⁵ Пленарный доклад

А.С. Буйневич, генеральный директор ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», Минск, Беларусь

11⁴⁵–12¹⁰ Современное состояние и перспективы развития

спецтехнологического оборудования, основанного на лазерных технологиях

С.М. Аваков, генеральный директор ОАО «ПЛАНАР», Минск, Беларусь

12¹⁰–12³⁵ Перспективы развития технологий СВЧ микроэлектроники в ОАО «МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ»

Ю.М. Кернасовский, директор ОАО «МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ», Минск, Беларусь

12⁴⁰–13⁰⁰ Российская электроника для гражданского рынка: Возможности и перспективы контрактного производства

П.П. Куцько, генеральный директор АО «НИИЭТ», Воронеж, Россия

13⁰⁰–14⁰⁰ Перерыв на обед

14⁰⁰–15⁴⁰ Секция №1

14⁰⁰–14²⁰ Оборудование и технология ГФЭ МОС гетероструктур на основе нитрида галлия диаметром до 200 мм

А.Ф. Цацульников¹, Е.Е. Заварин^{1,2}, В.В. Лундин², А.Е. Николаев¹, А.В. Сахаров¹

¹ НТЦ Микроэлектроники РАН, Санкт-Петербург, Россия

² ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

14²⁰–14⁴⁰ Разработка отечественного эпитаксиального и планарного оборудования для материалов А³В⁵ – переход от R&D к производственно-ориентированному уровню

А.Н. Алексеев, А.Д. Гердт, С.А. Новиков, С.И. Петров, М.А. Литвинов АО «НТО», Санкт-Петербург, Россия

14⁴⁰–15⁰⁰ Отработка технологии получения функциональных многокомпонентных слоев на основе твердых растворов AlGaN и InGaN

И.И. Марончук, М.В. Меженный, А.А. Чельный, Д.Д. Санникович, П.С. Рыбин, А.С. Тарасов

АО «Оптрон», Москва, Россия

15⁰⁰–15²⁰ Технологии молекулярно-пучковой эпитаксии нитридов для СВЧ и силовой электроники

Е.В. Луценко

Институт физики им. Б.И. Степанова, Минск, Беларусь

15²⁰–15⁴⁰ Разработка методики определения плотности дислокаций в гетероструктурах на основе GaN

И.И. Марончук, М.В. Меженный, А.А. Чельный, Д.Д. Санникович,

К.В. Ламбрианиди, А.С. Тарасов

АО «Оптрон», Москва, Россия

15⁴⁰–16²⁰ Перерыв на кофе

16²⁰–18⁰⁰ Секция №2

16²⁰–16⁴⁰ Материалы и технологии для защиты радиоэлектронного, оптоэлектронного и информационного оборудования, биологических объектов от широкого спектра электромагнитных излучений

О.В. Бойправ¹, С.С. Грабчиков², Ф.Ф. Комаров³, Н.И. Мухуров⁴

¹ Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь

² НППЦ НАН Беларуси по материаловедению, Минск, Беларусь

³ НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко БГУ, Минск, Беларусь

⁴ ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь

16⁴⁰–17⁰⁰ Особенности обработки оптических материалов ионно-лучевыми методами

Г.И. Рябцев¹, А.В. Григорьев¹, А.Г. Рябцев², М.В. Богданович²,

Н.Н. Новицкий³, А.И. Серокурова³

¹ Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь

² ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь

³ НППЦ НАН Беларуси по материаловедению, Минск, Беларусь

17⁰⁰–17²⁰ Разработка волноводного ферритового вентиля интегрированного в подложку

Е.А. Богомолова^{1,2}, Е.В. Медянцева^{1,2}, Д.В. Богомолов^{1,2}, А.В. Аксенов²

¹ АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина, Фрязино, Россия

² Филиал РТУ МИРЭА, Фрязино, Россия

17²⁰–17⁴⁰ Резонансные методы технического контроля и диагностики материалов для устройств микро-, опто- и СВЧ-электроники

А.В. Гусинский, Н.А. Певнева, В.Н. Родионова

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь

17⁴⁰–18⁰⁰ Пассивные компоненты для СВЧ монолитных интегральных схем на основе гетероэпитаксиальных структур нитридов III группы

Д.М. Цунваза, Р.В. Рыжук, А.С. Гусев, Р.В. Захарченко, Н.И. Каргин

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия

16 октября, четверг

09⁰⁰–10⁴⁰ Секция №3

09⁰⁰–09²⁰ Гетероструктуры на основе пленок из одностенных углеродных нанотрубок для оптоэлектронных приборов широкого диапазона температур

Е.А. Дронина¹, Н.Г. Ковальчук¹, А.Л. Данилюк¹, Е.В. Луценко²,
А.В. Данильчик², С.Л. Прищеп¹

¹ Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь

² Институт физики им. Б.И. Степанова, Минск, Беларусь

09²⁰–09⁴⁰ Методы обработки поликристаллического алмаза с целью изготовления теплоотводящих подложек для изделий микроэлектроники

Н.Д. Ильюшина, П.М. Ларина, А.К. Смирнова, А.С. Щеголев
АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина, Фрязино, Россия

09⁴⁰–10⁰⁰ Разработка технологии эпитаксиального наращивания многослойных структур кремния с резкими переходными границами

А.С. Дубкова, В.Н. Рябов, К.А. Халимова, И.В. Тарасов, С.А. Дубков
АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина, Фрязино, Россия

10⁰⁰–10²⁰ Локальная интеграция кристаллов СВЧ приборов методом перевернутого монтажа на основе тонкопленочной системы Au-Sn

А.С. Ефимов¹, В.Г. Лапин¹, А.А. Зайцев², В.П. Волкова¹, А.В. Груша¹

¹ АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина, Фрязино, Россия

² НИУ «МИЭТ», Зеленоград, Россия

10²⁰–10⁴⁰ Жидкие фоторезисты

А.П. Федотов

ООО «ФРАСТ-М», Москва, Россия

10⁴⁰–11²⁰ Перерыв на кофе

11²⁰–13⁰⁰ Секция №4

11²⁰–11⁴⁰ Моделирование широкополосного поляризатора на основе метаматериала с прямоугольными С-образными элементами с диагональными разрезами в СВЧ диапазоне

И.А. Фаняев¹, П.В. Сомов¹, А.Л. Самофалов¹, И.В. Семченко², С.А. Хахомов¹

¹ Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Гомель, Беларусь

² ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь

11⁴⁰–12⁰⁰ Оценка параметров диодов Шоттки с различными профилями легирования эпитаксиального слоя

С.А. Богданов

АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина, Фрязино, Россия

- 12⁰⁰–12²⁰ **Роль металлического ближнего окружения образцов при измерении фотокондактанса СВЧ-облучаемых полупроводниковых наносистем**
В.А. Ткаченко^{1,2}, А.С. Ярошевич¹, З.Д. Квон^{1,2}, И.В. Марчишин¹,
 А.К. Бакаров¹, Е.Е. Родякина^{1,2}, В.А. Антонов¹, В.П. Попов¹, О.А. Ткаченко¹,
 Д.Г. Бакшеев², А.В. Латышев^{1,2}
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск, Россия
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
- 12²⁰–12⁴⁰ **Моделирование двухканальных транзисторных GaAs-гетероструктур и НЕМТ на их основе**
С.Н. Карпов
 АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина, Фрязино, Россия
- 12⁴⁰–13⁰⁰ **Оптимизация AlGaIn/GaN структур для НЕМТ транзисторов**
А.В. Сахаров^{1,2}, Д.С. Артеев^{1,2}, А.Е. Николаев^{1,2}, Е.Е. Заварин^{1,2},
 С.Н. Родин^{1,2}, А.Ф. Цацульников^{1,2}
¹ НТЦ Микроэлектроники РАН, Санкт-Петербург, Россия
² ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия
- 13⁰⁰–14⁰⁰ Перерыв на обед**
- 14⁰⁰–15⁴⁰ Секция №5**
- 14⁰⁰–14²⁰ **Четырехканальный блок приемопередатчика для перспективной РЛС**
А.В. Адиатулин, М.С. Карасев, С.А. Щеголев
 АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина, Фрязино, Россия
- 14²⁰–14⁴⁰ **Метод измерения частоты СВЧ-сигналов в режиме реального времени с помощью электрооптического смесителя на основе модулятора Маха-Цендера**
Д.Ю. Сидлеров, К.Б. Микитчук, А.Л. Чижев
 ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь
- 14⁴⁰–15⁰⁰ **Термокомпенсация дрейфа рабочей точки СВЧ модуляторов на основе ниобата лития с помощью резисторов**
А.В. Сосунов¹, А.Ю. Киреев², А.А. Журавлев²
¹ Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия
² Пермская научно-производственная приборостроительная компания, Пермь, Россия
- 15⁰⁰–15²⁰ **Приемо-передающий модуль для систем с АФАР X-диапазона длин волн на российской ЭКБ**
С.А. Щеголев, М.С. Карасев, А.В. Адиатулин, Д.В. Калита
 АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина», Фрязино, Россия
- 15²⁰–15⁴⁰ **Метод оценки зависимости частоты от времени на основе частотно-временного преобразования для сигналов сверхширокополосных радиофотонных систем**
 А.В. Колейчик, К.Б. Микитчук, А.Л. Чижев
 ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь

15⁴⁰–16²⁰ Перерыв на кофе

16²⁰–18⁰⁰ Стендовая секция

- 1) Моделирование электрических и оптических свойств гетероструктурного соединения графена и диселенида молибдена
В.Н. Мищенко, А.Д. Васютич, А.С. Вабищевич
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь
- 2) Технологические особенности нанесения алмазоподобных слоев и покрытий нитрида титана плазменными методами
А.Н. Купо¹, В.А. Емельянов²
¹ *Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Гомель, Беларусь*
² *ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», Минск, Беларусь*
- 3) Закономерности формирования регистрируемого сигнала активно-импульсными системами видения для второго способа наблюдения
Б.Ф. Кунцевич, И.Н. Пучковский, С.С. Шавель, С.Б. Бушук
ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь
- 4) Оптоэлектронный блок регистрации излучения с разделением по поляризации
С.С. Шавель, В.А. Горобец, С.Б. Бушук
ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь
- 5) Автокоррекция положения лазерного луча на мобильной цели
С.Б. Бушук, П.Н. Назаренко, В.В. Пекаревич, Р.А. Тавтын
ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь
- 6) Влияние топологических параметров ИК МФПУ на погрешность измерения ЧКХ объективов
А.Д. Юдовская, Н.А. Соломонова, Н.А. Семенченко
АО «НПО «Орион», Москва, Россия
- 7) Разработка объективов с использованием оптических элементов, изготовленных методом прецизионного прессования
Д.А. Машошин, Д.Д. Ролдугина, Т.С. Сайкина
АО «НПО Орион», Москва, Россия
- 8) Структура и оптические свойства нанокристаллических слоев SnO₂ на кремнии для светоизлучающих и сенсорных систем
И.С. Роговая¹, О.В. Мильчанин¹, Ф.Ф. Комаров¹, М.В. Пузырев¹, И.Н. Пархоменко², В.Д. Живулько³
¹ *НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко БГУ, Минск, Беларусь*
² *Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь*
³ *НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, Минск, Беларусь*
- 9) Разработка и исследование широкополосного микроволнового поглотителя на основе резистивных контуров
А.С. Мигель, Н.В. Любецкий, Е.С. Максимович
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
- 10) Энергонезависимая память на основе тонкопленочных халькогенидных мемристорных элементов
Е.Ф. Троян, А.Г. Смирнов, А.А. Степанов, Н.В. Жовнерик
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь

- 11) Формирование высокоомных резистивных пленок нитрида кремния-титана методом совместного реактивного магнетронного распыления**
Д.А. Голосов¹, С.М. Завадский¹, Я.А. Соловьев², А.И. Занько², С.Н. Мельников¹, П.А. Александрович¹, К.А. Бородич¹
¹ *Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь*
² *ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», Минск, Беларусь*
- 12) Применение термоэлектрогенераторов для создания гибридных солнечных элементов**
А.В. Нестеренок, В.В. Малютина-Бронская, В.М. Кравченко
ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь
- 13) Медная металлизация для солнечных элементов**
А.С. Кузьмицкая, В.М. Кравченко, В.В. Малютина-Бронская, А.В. Нестеренок
ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь
- 14) Энергетические характеристики мощных СВЧ-фотодиодных модулей с оптическим усилителем и без оптического усилителя**
Н.А. Чиж, К.Б. Микитчук
ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь
- 15) СВЧ термоаттенюаторы с применением терморезистивных паст, совместимых с отечественными материалами ЛТСС**
В.С. Горяйнов¹, Д.Н. Полозов¹, В.М. Коломин¹, Д.А. Волкова¹, В.И. Алексеенков¹, А.Л. Курапова¹, М.К. Кутузов²
¹ *АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина, Фрязино, Россия*
² *ООО «Элма-Пасты», Зеленоград, Россия*
- 16) Исследования морфологии и магнитных свойств быстрозакаленных сплавов системы Fe-Si-B-Nb и Fe-Co-B**
М.А. Степович¹, Т.П. Каминская², М.Н. Шипко³, Е.С. Савченко⁴, А.А. Вирюс⁵
¹ *Ивановский государственный университет, Иваново, Россия*
² *Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия*
³ *Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, Иваново, Россия*
⁴ *Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», Москва, Россия*
⁵ *Институт экспериментальной минералогии им. Д.С. Коржинского РАН, Черноголовка, Россия*
- 17) Радиационная стойкость IGBT транзисторов**
В.Н. Ювченко¹, С.А. Мискевич¹, Ф.Ф. Комаров¹, Н.С. Ковальчук², М.М. Кречко³, С.В. Шпаковский³
¹ *НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко БГУ, Минск, Беларусь*
² *ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», Минск, Беларусь*
³ *Филиал НТЦ «Белмикросистемы» ОАО «ИНТЕГРАЛ», Минск, Беларусь*
- 18) Оптоэлектронные синапсы для нейроморфных вычислений на основе Ga₂O₃ солнечнослепых УФ-фотоприемников**
Н. Sun¹, В. Ye¹, М. Ge², В. Gong¹, L. Qian¹, И.Н. Пархоменко³, Ф.Ф. Комаров⁴, Y. Liu⁵, G. Yang¹
¹ *Школа науки, Цзяннаньский университет, Уси, Китай*
² *Школа микроэлектроники, Нантонгский университет, Нантонг, Китай*

³ Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

⁴ НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко БГУ, Минск, Беларусь

⁵ Центр квантовых приборов Института Н. Бора Копенгагенского университета, Копенгаген, Дания

19) Улучшение плоскостности полупроводниковых подложек с помощью тонких пленок нитрида кремния

С.А. Демидович^{1,2}, Н.С. Ковальчук¹

¹ ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», Минск, Беларусь

² Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь

20) Формирование изоляции для транзисторов с высокой подвижностью электронов ионной имплантацией бора в гетероструктуру AlGaIn/GaN

А.Д. Юник, Д.В. Ребенок, С.В. Козодоев, Н.С. Ковальчук, Я.А. Соловьев

ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», Минск, Беларусь

21) Применение меза-изоляции в гетероструктурах AlGaIn/GaN при формировании транзисторов с высокой подвижностью электронов

А.Д. Юник, А.В. Татьянаенко, А.Г. Шидловский, Я.А. Соловьев

ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», Минск, Беларусь

22) Оптимизация алгоритма измерения постоянной времени микроболометра

А.Е. Жамойть, Т.А. Климович, А.И. Занько

ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», Минск, Беларусь

23) Герметизация микроболометров вакуумной пайкой на установке SST 3150

А.Э. Видрицкий¹, В.Л. Ланин²

¹ ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», Минск, Беларусь

² Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь

24) Гибридные наноматериалы для микроэлектроники и нанофотоники

А.И. Поняев¹, Л.И. Рудая^{1,2}, М.Н. Большаков², А.Ю. Марфичев²

¹ Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Санкт-Петербург, Россия

² Филиал Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» – Институт высокомолекулярных соединений, Санкт-Петербург, Россия

25) Коллоидные квантовые точки сульфидов металлов для фотодетекторов: особенности синтеза, влияющие на размер наночастиц

М.Г. Спириин¹, П.Б. Матюхин¹, С.Б. Бричкин¹, В.Ф. Разумов^{1,2}

¹ Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, Черногловка, Россия

² Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Россия

26) Экспериментальная светодиодная установка для выращивания гидропонного зеленого корма и оценка ее эффективности

С.И. Лишик¹, П.В. Ковальчук¹, Ю.В. Трофимов¹, В.Э. Парецкий², Е.В. Парецкий²

¹ Государственное предприятие «ЦСОТ НАН Беларуси», Минск, Беларусь

² УП «ГРИН СЭТ», Минск, Беларусь

- 27) Беспорядок и эффективность фотогенерации в органических полупроводниках: исследование методом Монте-Карло**

Д.Н. Литвиненко, В.Р. Никитенко

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия

- 28) Разработка технологии синтеза титаната кальция и оценка его применимости в фильтрах нижних частот**

А.А. Смирнова¹, Н.С. Карасев^{1,2,3}, Д.А. Соколов^{1,3}, В.М. Коломин^{1,3}, Д.А. Волкова¹, Р.А. Бесплеменная¹

¹ АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина, Фрязино, Россия

² Филиал РТУ МИРЭА, Фрязино, Россия

³ РТУ МИРЭА, Москва, Россия

- 29) Высокотемпературный синтез нитрида титана из TiO₂ и углеродсодержащего реагента в азотной атмосфере**

А.Д. Соколов^{1,3}, В.М. Коломин^{1,3}, Н.С. Карасев^{1,2,3}, С.С. Монов¹, Л.В. Левашова¹, Д.А. Соколов^{1,3}, Р.А. Бесплеменная¹, А.Н. Юрасов³

¹ АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина, Фрязино, Россия

² Филиал РТУ МИРЭА, Фрязино, Россия

³ РТУ МИРЭА, Москва, Россия

- 30) Широкополосное баночное окно на смешанной моде (TE₁₁+TM₁₁) с волноводным резонатором**

Е.В. Медянкова^{1,2}, А.В. Галдецкий¹, Е.А. Богомолова^{1,2}, А.Н. Савин¹,

Д.В. Богомолов^{1,2}, А.С. Сергеева²

¹ АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина, Фрязино, Россия

² Филиал РТУ МИРЭА, Фрязино, Россия

- 31) Структура и электромагнитные свойства литий-цинковых ферритов, изготовленных аддитивным методом**

Е.Н. Лысенко¹, А.С. Свирков¹, С.А. Артищев²

¹ Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия

² Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, Россия

- 32) Оптические свойства пленок CdS, полученных методом химического наслаивания или осаждения**

Н.В. Богомазова¹, В.В. Жилинский¹, В.С. Федосенко², Г.Г. Горох²

¹ Белорусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь

² Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь

- 33) Особенности оптических свойств пленок оксида цинка, полученных различными методами**

С.В. Денисюк¹, О.Н. Куданович¹, И.В. Гасенкова¹, Н.И. Мухуров¹, А.А. Ходин¹, Н.А. Босак²

¹ ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь

² Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь

- 34) Морфологические, оптические и электрофизические свойства пленок**

La_{0.5}Sr_{0.5}Co_{0.9}Ni_{0.1}O₃, полученных при импульсном лазерном осаждении в вакууме

Н.А. Босак¹, М.В. Бушинский², Л.В. Баран³, В.В. Малютин-Бронская⁴,

О.С. Мантыцкая², А.С. Кузьмицкая⁴

¹ Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь

² НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, Минск, Беларусь

³ Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

⁴ ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь

35) Анализ переключательной динамики в ячейках памяти MRAM на основе FeCoV/MgO с учетом структуры интерфейса

К.К. Абгарян

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН, Москва, Россия

36) Влияние структурного совершенства на магнитные свойства пленок

Sr₂Fe_{1+x}Mo_{1-x}O_{6-δ}, полученных методом ионно-лучевого напыления

А.Г. Юденков¹, А.Н. Петлицкий¹, Н.А. Каланда², А.В. Петров², С.С. Старухина³, А.С. Быков³, Д.А. Киселев³

¹ НТЦ «Белмикросистемы» ОАО «ИНТЕГРАЛ», Минск, Беларусь

² НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, Минск, Беларусь

³ Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», Москва, Россия

37) Влияние структурного совершенства на магнитные свойства пленок

Sr₂Fe_{1+x}Mo_{1-x}O_{6-δ}, полученных методом ионно-лучевого напыления

А.Г. Юденков¹, А.Н. Петлицкий¹, Н.А. Каланда², А.В. Петров², С.С. Старухина³, А.С. Быков³, Д.А. Киселев³

¹ НТЦ «Белмикросистемы» ОАО «ИНТЕГРАЛ», Минск, Беларусь

² НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, Минск, Беларусь

³ Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», Москва, Россия

38) Оптоэлектронное устройство для оценки физиологического состояния растений на основе анализа спекл-паттернов их листьев

С.И. Лишик¹, А.И. Щитникова¹, П.В. Ковальчук¹, П.П. Першукевич¹, Ю.В. Трофимов¹, Х.Х. Льовега-Гонсалес²

¹ Государственное предприятие «ЦСОТ НАН Беларуси», Минск, Беларусь

² Технологический университет Гаваны «Хосе Антонио Эчеверрия», Гавана, Куба

17 октября, пятница

09⁰⁰–10⁴⁰ Секция №6

09⁰⁰–09²⁰ **Антиотражающее оптическое покрытие на основе слоя нанопористого германия, сформированного имплантацией ионами висмута**

А.Л. Степанов, А.М. Рогов, В.Ф. Сотникова, В.Ф. Валеев, В.И. Нурждин, Д.А. Коновалов

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, Россия

09²⁰–09⁴⁰ **Исследование структурных свойств и фоточувствительности пленок оксида галлия на сапфире, полученных различными методами**

Д.С. Королев¹, П.А. Юнин^{1,2}, К.С. Матюнина¹, Д.А. Сорокин¹, А.А. Никольская¹, В.Н. Трушин¹, А.Г. Терехов¹, Е.Р. Тютина¹, Д.И. Тетельбаум¹

¹ *ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия*

² *Институт физики микроструктур РАН, Нижегородская обл., д. Афонино, Россия*

09⁴⁰–10⁰⁰ **Фоточувствительные кристаллические структуры тииодида висмута**

И.А. Свито¹, Е.А. Стрельцов¹, А.И. Кулак², А.В. Мазаник^{1,3}

¹ *Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь*

² *Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь*

³ *Институт энергетики НАН Беларуси, Минск, Беларусь*

10⁰⁰–10²⁰ **Воздействие высоких концентраций алкиламмониевых катионов на структуру и светопоглощение металлоорганических перовскитных пленок**

В.С. Будник, А.К. Тучковский

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь

10²⁰–10⁴⁰ **Стеклолюминофорные преобразователи с высокой устойчивостью к лазерному излучению и индексом цветопередачи**

С.И. Лишик¹, Л.Н. Сурвило¹, Н.Н. Грушко¹, Ю.В. Трофимов¹, В.И. Цвирко¹, В.Н. Павловский², Е.В. Луценко², Ци Цань³, Лью Жиганг³

¹ *Государственное предприятие «ЦСОТ НАН Беларуси», Минск, Беларусь*

² *Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь*

³ *Институт энергетических исследований Шандуньской академии наук, Цзинань, Китай*

10⁴⁰–11²⁰ Перерыв на кофе

11²⁰–13⁰⁰ Секция №7

- 11²⁰–11⁴⁰ **Недисперсионные инфракрасные газовые датчики на основе свето- и фотодиодов из полупроводников InAsSb(P)**
С.А. Карандашев, А.А. Климов, Р.Э. Кунков, Т.С. Лухмырина, Б.А. Матвеев, М.А. Ременный
 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
- 11⁴⁰–12⁰⁰ **Фотодиоды для лазерной дальнометрии на основе A³B⁵ полупроводниковых структур**
А.А. Васильев, Е.Д. Мазун, И.О. Воропаева, К.О. Воропаев
 АО «ОКБ-Планета», Великий Новгород, Россия
- 12⁰⁰–12²⁰ **Измерение ширины линии лазерных диодных модулей с нестабилизированной частотой генерации**
В.В. Шестак, К.Б. Микитчук, А.Л. Чижев
 ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь
- 12²⁰–12⁴⁰ **Исследование и разработка многоканальных волоконно-оптических жгутов и сенсоров для научных исследований и промышленности**
Г.Л. Даниелян^{1,2}, Г.В. Назарова², В.В. Кашин², Н.А. Иванов², О.В. Вихрова², О.Д. Морозова¹
¹ Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
² ООО «НТЦ Волоконно-оптических устройств», Москва, Россия
- 12⁴⁰–13⁰⁰ **Стенд для комплексных измерений и контроля энергетических характеристик оптико-электронных приборов, работающих в ультрафиолетовом диапазоне спектра**
Д.А. Егошин, В.И. Курт, Д.Ю. Васильев
 АО «НПО ГИПО», Казань, Россия
- 13⁰⁰–14⁰⁰ Перерыв на обед**
- 14⁰⁰–15⁴⁰ Секция №8**
- 14⁰⁰–14²⁰ **Кремниевые высокочувствительные мультипиксельные фотодиоды работающие в режиме усиления в корпусе для поверхностного монтажа**
В.В. Малютина-Бронская¹, С.А. Сорока¹, В.С. Цымбал², А.М. Лемешевская², А.Б. Смирнов², С.В. Шпаковский²
¹ ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь
² ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», Минск, Беларусь
- 14²⁰–14⁴⁰ **Детекторы ионизирующего и ультрафиолетового излучения малой интенсивности на базе кремниевых фотоумножителей**
В.В. Малютина-Бронская¹, С.А. Сорока¹, А.В. Якушев¹, Н.А. Раценя², М.И. Новик², П.В. Кучинский²
¹ ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь
² НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко БГУ, Минск, Беларусь

- 14⁴⁰–15⁰⁰ **КМОП-матрица для управления массивом светоизлучающих наноструктур**
И.И. Шрамов¹, А.А. Степанов¹, А.Г. Смирнов¹, К.В. Корсак¹, Е.В. Муха¹, А.М. Можаров², В.В. Федоров², И.С. Мухин²
¹ *Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь*
² *Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет им. Ж.И. Алферова РАН, Санкт-Петербург, Россия*
- 15⁰⁰–15²⁰ **Матричный термооптический преобразователь**
А.С. Кузьмицкая, В.М. Кравченко, А.И. Конойко, В.А. Солодуха
ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь
- 15²⁰–15⁴⁰ **Программный комплекс обработки изображения тепловизионной системы спектрального диапазона 3–5 мкм**
Д.Э. Драгунов, М.Ю. Ляпустин, П.С. Лазарев, В.С. Бубнов, В.Д. Антипов, А.В. Полесский, К.А. Хамидуллин, В.В. Старцев
АО «НПО Орион», Москва, Россия
- 15⁴⁰–16²⁰ Перерыв на кофе**
- 16²⁰–18⁰⁰ Секция №9**
- 16²⁰–16⁴⁰ **Динамическое изменение режима работы фотопроводящего полупроводникового ключа параметрами управляющего лазерного излучения**
В.В. Бармин, И.В. Романченко
Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия
- 16⁴⁰–17⁰⁰ **Имитация динамических сцен в инфракрасном диапазоне спектра на основе микрозеркальных технологий**
Д.Ю. Васильев, В.И. Курт, Д.А. Егошин
АО «НПО ГИПО», Казань, Россия
- 17⁰⁰–17²⁰ **Оптическая диагностика фотоиндуцированных процессов в перовскитных солнечных элементах**
А.В. Мазаник
Институт энергетики НАН Беларуси, Минск, Беларусь
- 17²⁰–17⁴⁰ **Разработка принципа построения сверхширокополосной гибридной интегральной схемы радиофотонного сигнального процессора**
М.Е. Белкин¹, М.Г. Васильев², А.А. Воронина¹
¹ *РТУ МИРЭА, Москва, Россия*
² *ФГБУН ИОНХ РАН, Москва, Россия*
- 17⁴⁰–18⁰⁰ **Закрытие конференции**